

## 半導体 素子 製造의 Yield 改善

張 東

韓國電子(株) 半導體事業部, 工場長

### I. 序論

半導体 素子의 yield 改善이란 쉬운 것이 아니다. 그러나 결코 어려운 것도 아니라는 것이 半導体 産業界에 몸담은 과거 15年餘의 經驗이다.

重要한 것은 어떠한 곳에 焦點을 맞추어서 問題解決을 어떻게 천천히 하느냐 하는 것이다. 實戰속에는 페이퍼에 없는 各種 knowhow가 있게 마련이다. 즉 長期間의 經驗에 依한 技術蓄積이라 생각되지만 그것들을 相互 어떻게 有効適切하게 利用하고 應用하느냐 하는 것이直接 Yield 改善에 影響을 준다고 본다. 半導体 素子 製造 프로세스를 크게 나누면,

- 單結晶 製作
- 웨이퍼狀 製作加工
- Wafer Fabrication (칩製造)
- 어셈블리(成品組立)

로 나눌 수 있겠으나 本文에서는 當社가 操業하고 있는 Wafer Fab, 어셈블리 兩工程에 對해서만 概念的인 側面에서 記述할까 한다.

### II. 本論

Wafer Fab工程, 어셈블리工程으로 크게 나누었을 때 각 工程이 갖고 있는 特殊性때문에 問題解決을 위한 接近方法도 다르다 할 수 있겠다. 즉 Wafer Fab工程이 素子의 機能을 갖추기 위한 各單位 製造工程의 製造條件이 決定되는 것에 對하여 어셈블리工程은 갖춰진 機能을 最大로 利用可能케 하는 形態로 만들어 주는 것과 한편 生產技術의 側面에서 보면 wafer fab工程이 batch 處理方式임에 反하여 어셈블리工程은 個別 칩 自動處理方式이라는 差異點도 重要한 意味를 갖는다고 이야기할 수 있겠다. 그러면 yield 改善의 側面에서 兩工程의 重要度는 어떠한가 考察해 본다면 혼히 特性을 決定하지 않는 어셈블리工程에는 技術의

興味의 弱化로 소홀히 하기 쉬운 傾向이 있으나 量產工程에 있어서는 그 重要度가 兩工程이 同等한 技術的水準이어야 된다고 생각된다. 半導体의 信賴性 퀴즈은 大端히 서어비스하게 要求되는 바 이 點을 特히 注目할必要가 있겠다. 各 工程別로 重要한 點들을 概略的으로 說明한다면,

#### 1. 原資材의 Incoming Inspection

우리 나라 半導体 業界 大部分의 경우처럼 웨이퍼等他 原資材를 外國에서 輸入해 오는 경우에 對해서는 最少限의 裝備로 絶對必要한 spec만이라도 체크를 해履歷을 整理할 必要가 있겠다.

#### 2. Wafer Fabrication工程

##### 1) Broken Wafer

Broken wafer의 yield에 미치는 影響은 實로 多大하다. 適定 Jig의 改善과 技能工들의 注意心이 무엇보다도 要求된다. 또한 레이아웃의合理的構成을 通한 Human Factor의 감소(즉 機能工들의 動線단축 및 連結工程의合理的 배치)等이 고려할 事項이 된다.

##### 2) プロセス

###### ① Diffusion and Oxidation

熱處理工程이 얼마나 重要한 것인지는 익히 잘아는 事項이지만 高溫加工의 경우에 어떤 方法으로 웨이퍼의 thermal shock를 줄여 주느냐 하는 것은 매우 어려운 問題다. 特히 low noise, fine pattern 素子에는 절대적으로 热에 依한 damage를 줄여 주어야만 한다. 고려되어야 할 事項으로는 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.

- 擴散爐에 웨이퍼를 넣을 때와 꺼낼 때
- 擴散溫度와 擴散時間의 고려
- Wafer container에 웨이퍼의 로딩方法
- 不純物 種類에 따른 擴散爐의 배치 및 プロセス

### 方法에 따른 구분

- 高温 프로세스 後 damage 緩和를 為한 annealing 方法의 研究

• 上記의 事項을 고려한 酸化方式의 細分化(工程 自體의 性質에 따른 프로세스 温度 決定 및 L.T.O (low temperature oxidation)의 채용, C.V.D 方式의 채용등.)

### ② Etchant

Etchant의 管理는 製品의 再現性을 좌우하므로 매우 重要하기 때문에 作業標準化(factory standard) 確立을 우선으로 한다. 內容으로는 etchant를 構成하는 chemical의 適正配合率維持, 適正 etching液 温度의 常時維持等의 必要性은 두말할 必要가 없겠다. 또 하나를 더 든다면 一定한 時間 또는 一定量의 作業後液의 交換도 무엇보다 重要하다 하겠다.

### ③ P.E.P(Photo Engraving Process)

P.E.P.室의 환경은 매우 엄하게 管理되어야 한다. 그 理由는 使用되는 材料는 물론 處理中인 製品까지도 환경에 따라 민감하게 變化되기 때문이다. 管理項目을 나눠보면 다음과 같다.

- 室內의 温度와 濕度의 管理
- Dust管理
- 照明管理
- Chemical 保管 場所 및 交換

### ④ Back Metallization

#### 著眼事項은

- Metal의 適正選擇
- Evaporation時의 真空度( $10^{-7}$  torr 程度)
- Growth rate
- Bell Jar 内部溫度

### ⑤ Probing

테스트 프로그램의 適正化(相關性面), inking의 color, dot size 問題 等은 充分한 檢討가 있어야겠다.

### ⑥ Sawing 및 Cracking

Fabrication 工程에서 最終處理工程으로 대단히 重要的工程으로서,

- Sawing M/C의 適正品 選擇
- Sawing speed
- Cracking時의 適正條件 確保 等은 hair crack의 防止에 最善의 길이 될 것이며 이는 素子의 信賴性과 直接的인 聯關을 갖는다.

## 3. 어셈블리 工程

### 1) Die 利用率

適正 expansion條件, tape의 選擇, sawing의 適正

化 等은 半導体 素子의 어셈블리 作業時 特性的 uniformity를 最大로 높여준다.

### 2) プロセス

#### ① Die Bonding

Die collector, work stage의 適正 温度維持 不活性 gas의 雾圍氣 檢討

#### 2) Wire Bonding

Wire size, work stage의 温度, 不活性 gas 雾圍氣 檢討

#### 3) Testing

프로그램의 適正化, 特히 double test를 必要로 한다. 品名 mixing은 致命不良이다.

#### 4) Marking

mark耐性을 如何히 level up 시킬 것인가 研究必要

## 4. Utility

### 1) 純水(DI Water)

純水는 比抵抗이  $18 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$  at  $25^\circ\text{C}$  以上의 純度 및 絶對量을 維持必要하며 bacteria의 發生防止 및 除去, 微粒子의 filtering, silica의 不含有, 特히 最近의 純水洗滌이 噴射式일 때 靜電氣 發生으로 인한 dust附着防止를 為한  $\text{CO}_2$  添加方法은 檢討의 餘地가 있다고 보겠다.

### 2) 空調

周圍環境의 大氣污染程度 檢討, 温度, 濕度, cleanliness의 適正設計는 若干 spec을 over하는 線이 必要.

### 3) 各種 Gas

$\text{O}_2$ ,  $\text{N}_2$ ,  $\text{H}_2$  他 doping gas를 除外하고自家 plant를 갖든지 liquid gas를 vapor시켜 使用하는 것이 바람직스러우며 purifier는 可能한限 附着시키는 것이 좋겠다. 特히 assembly側의 forming Gas의 配合率에는 充分한 考慮가 있어야 한다고 생각된다.

## 5. 웨이퍼의 汚染(Contamination)

웨이퍼에 汚染이 되었는지 안되었는지의 判斷은 대단히 어렵다. Dopant의 汚染에 對해서는 作業, booth, 各種 jig의 專用化, tube의 定期的洗滌 等이 所望스러우며 汚染發見 管理方法中에는  $1050^\circ\text{C}$  dry  $\text{O}_2$  中에 1時間 정도의 oxidation으로 자란 膜色을 觀察하는 方法, 汚染된 酸化膜으로 MOS 다이오드를 形成시켜 C-V特性을 測定하는 方法 等이 생각될 수 있으며 적극적으로 管理할 必要가 있다. 또한 오퍼레이터의 clean服 靜電氣 發生, 女子 오퍼레이터의 化粧方法도 充分한 檢討가 되어야 하겠다.

## 6. 安全

以上 하게도 安全關係가 適正하게 管理가 되면 yield가 改善된다. 排出 Gas(특히 SiH<sub>4</sub>)等의 適正排出, chemical의 適正管理等은 直接 yield에 영향을 미친다고 보아도 不足함 없으니 人的, 資源的側面의 安全은 두 말할 것도 없이 yield 側面에서도 檢討가 充分히 이루어져야겠다.

参考로 當社(韓國電子(株))의 yield를 본다면

Wafer fab 90%

어셈블리 95% 程度가 平均 레벨이다.

## III. 結論

以上 概略의 内容을 記述했으나 各 工程別로 檢討된다면 깊은 理論的 根據를 배경으로 相互工程間에 聯關性을 充分히 檢討하여 密度있게 接近해야 된다고 생각한다. 어쨌든 “Yield 改善은 信賴性의 改善”이라 이야기 할 수 있겠다. Wafer Fab, 어셈블리 兩工程의 特殊性을 充分히 把握檢討, 作業 lot 全體의 yield up은 信賴性 up으로 直結된다는 것은 半導体 素子部品에 對해서 重要한 意味를 갖는다 하겠다. \*\*\*

## 알아둡시다

### ◆ Concentration

많은 input subchannel이 작은 output channel (subchannel을 모두 함께 수용할 수 없는 정도의 전송용량을 가진 채널)을 활용하려는 concentration 방법에는 다음과 같은 것이 있다. 즉, 들어오는 서브채널의 데이터를 전혀 메모리하지 않는 방법인 라인 스위칭과 메모리하는 방법이 있다. 후자의 경우는 잠시 메모리하는 소위 “hold-and-forward”(Asynchronous Time Division Multiplexing; ATDM) concentrator와 tape나 disk, drum 등에 비교적 길게 메모리하는 “store-and-forward(message switching) 방식이 있다.

### ◆◆ Asynchronous Time-Division Multiplexing (ATDM)

i) line-sharing 방법은 multiplexing과 concentration의 양형태를 다 갖춘 hybrid형으로서, statistical multiplexer 혹은 multiplexer concentrator라고도 한다. 결론적으로 이 방식을 부르는 용어를 나열하면, concentrator, hold-and-forward concentrator, multiplexer concentrator, statistical concentrator, asynchronous time-division multiplexer의 다섯가지가 된다.

대개의 remote terminal은 실제로 온라인 시간의 10%이내로 데이터 전송을 하게 되므로, STDM에서와 같이 고정된 frame format으로 time slot을 배

분 활용하게 되면 상당한 time slot이 무용지들이 되어 버린다. 이점을 방지하려는 것이 바로 ATDM의 기본 목표이다. 즉 당장 데이터 전송을 요구하는 active user에게만 time slot를 배정하므로서 못쓰게 되는 time slot을 줄여 전반적인 선로 이용도와 데이터 전송율을 높이려는 것이다. 해석적인 연구 결과는 이 방법으로서 voice grade line의 경우 STDM보다 2~4배의 end user를 수용할 수 있는 것으로 나타나 있다. 한편 concentrator(ATDM) 기본적인 기능에는 다음과 같은 것이 있다.

- 1) Buffering-low speed line으로 들어오는 데이터를 date block 단위로 저장한다.
- 2) Allocation of storage and control of queues terminal의 데이터 전송 요구시간과 data message 길이가 일정치 않으므로 subchannel을 위한 storage 배분과 queuing delay를 조정해야 한다.
- 3) Receipt of messages on the low speed-lines, 각 subchannel을 계속해서 scanning, sampling, storing을 한다.
- 4) Code translation: 송수신 data stream의 code를 같은 것으로 변환한다.
- 5) Assembly and transmission of messages on high-speed lines addressing, sequencing, synchronization 등.
- 6) error checking, polling.